1　主要用途与主要特点

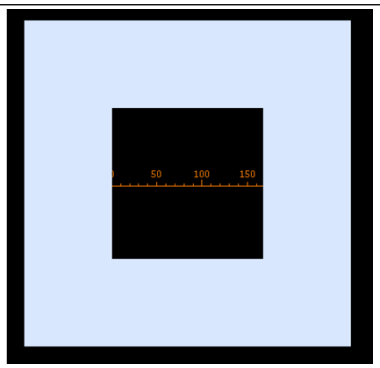
1.1　主要用途

用 W1XT551N 封装的成品管主要用于便携式电子产品中电源端的 ESD 保护。

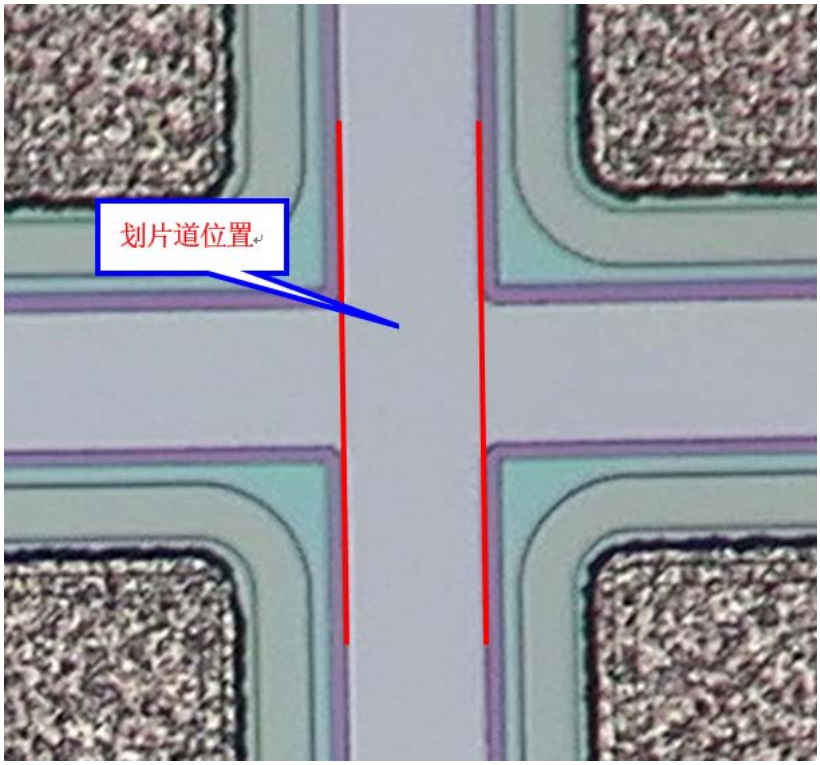
1.2　主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

2　芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸（mm×mm）		0.4×0.4	
	芯片厚度（μm）（推荐）		≤170	
	划片道*尺寸（μm）		45	
	键合区面积（μm²）	正面	168×168	
	正面电极	金属	铝	
		厚度	5.0±1.0	
	背面电极	表层金	银	金
	装片要求（推荐）		低温共晶	共晶
	硅片直径（mm）		φ125	
	键合要求（推荐）		铜丝；φ32μm；2 根	

* 划片道位置示意图：



3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定，T_{amb}= 25℃

参 数 名 称	符号	额定值	单位	备注
结温	T_j	150	℃	推荐封装形式： 推荐成品：
贮存温度	T_{stg}	-40～150	℃	

3.2 电参数

除非另有规定，T_{amb}= 25℃

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	I_R= ±1mA	4.5		6.5	V
反向电流	I_R	V_R= ±3V	—	—	1	μA
结电容	C_{tot}	V_R=0V，f= 1MHz	—	40	—	pF
峰值电压	V_C	I_{PP}= ±25A(8×20μs	—	—	20	V

3.3典型特性曲线

暂无

注意事项：

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 25±5℃，湿度≤45%；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。